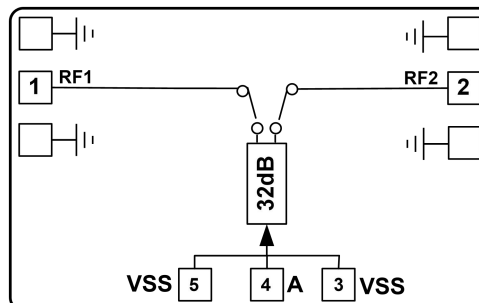




主要特点

内部集成TTL驱动
射频端口内部集成下拉电阻
衰减范围: 32 dB
衰减精度: ± 1 dB
插入损耗: 1.5 dB
输入/输出: 50 Ohm 匹配
芯片尺寸: $1.0 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

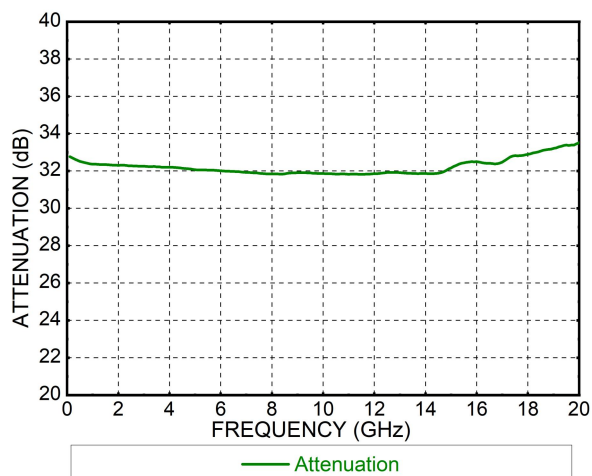
功能框图



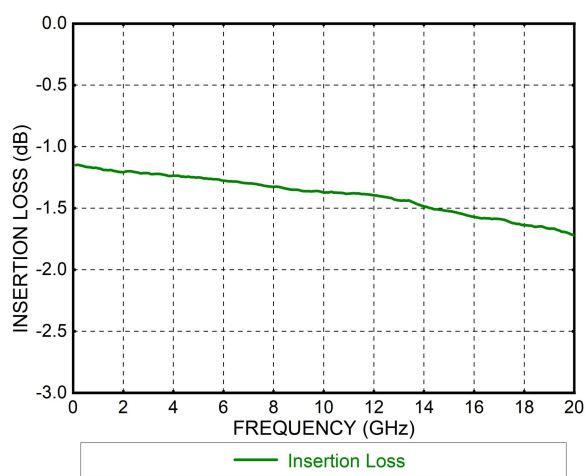
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{SS} = -5$)

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率		0.1 - 20		GHz
插入损耗		1.5		dB
衰减范围		32		dB
回波损耗		20		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-20GHz		24		dBm
切换时间		30		ns

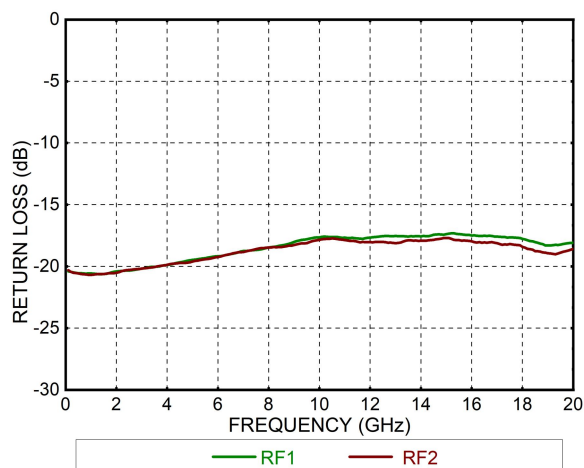
衰减量



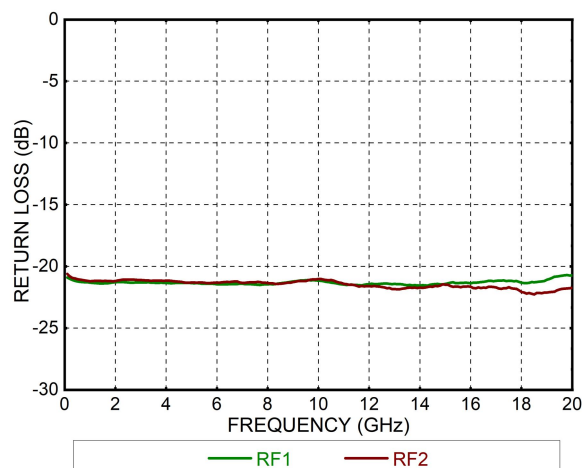
插入损耗



参考态回波损耗

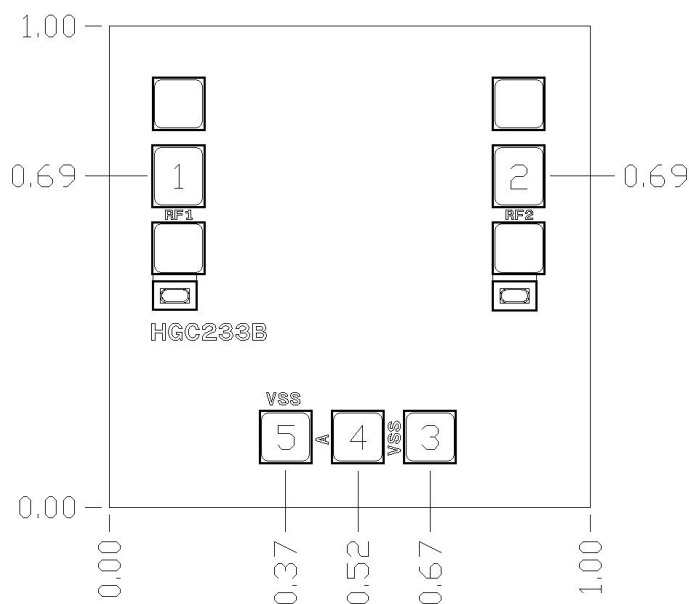


衰减态回波损耗



物理参数

单位: mm



焊盘描述

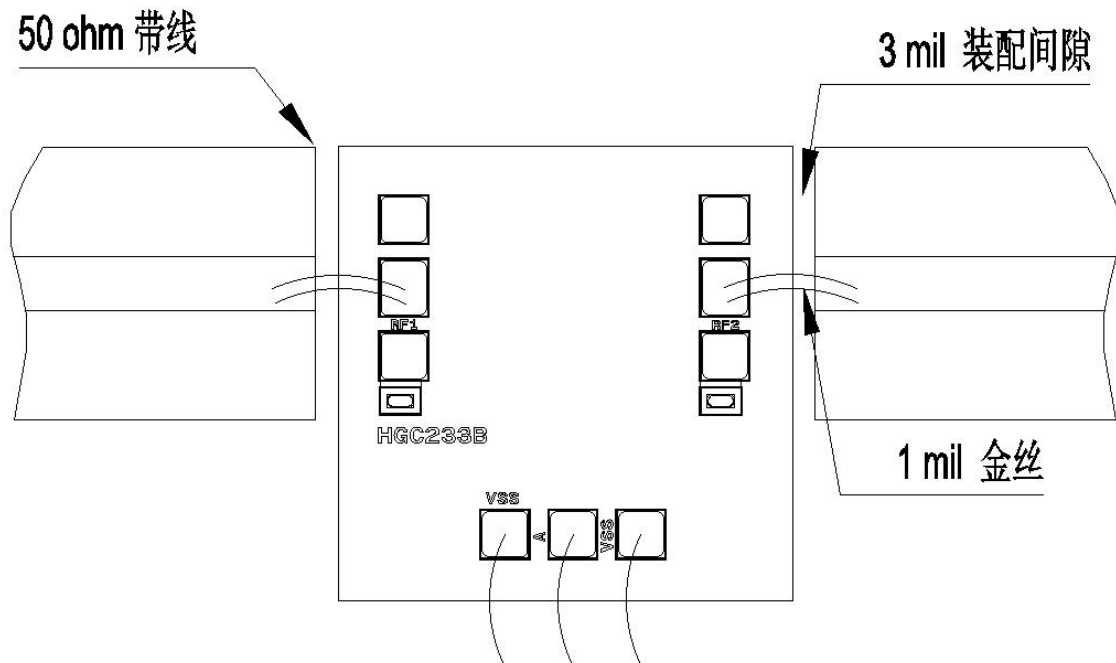
焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 需要外部加入隔直电容
3, 5	VSS	该焊盘是 TTL 驱动电路电源端口, 接-5V 电源, 使用时任选一个即可
4	A	该焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

状态	A
参考态	0
32dB	1
“0” 电平范围: 0~0.8V; “1” 电平范围: 2.3~5V	

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100um
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100um²
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN; 厚度: 0.6um

极限参数

1. 射频输入功率: +27 dBm
2. 储存温度: -65 ~ +150 °C
3. 工作温度: -55 ~ +85 °C